

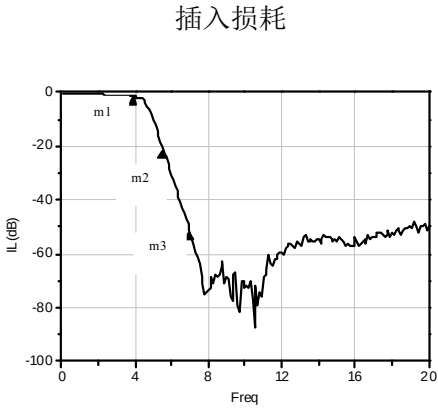
关键指标

- 通带频率：DC~4GHz
- 插入损耗：1.7dB
- 阻带衰减：20dB@5.6GHz , 40dB@6.2GHz
- 回波损耗：25dB/25dB
- 芯片尺寸：1.8mm×1mm×0.1mm

电性能（TA=25℃）

指标	最小值	典型值	最大值
频率(GHz)	DC~4		
输入回波损耗(dB)	-	25	-
输出回波损耗(dB)	-	25	-
插入损耗(dB)	-	-	1.7
阻带衰减 @5.6GHz(dB)	-	20	-
阻带衰减 @6.2GHz(dB)	-	40	-

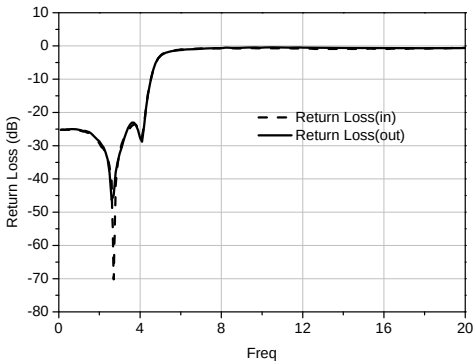
典型测试曲线



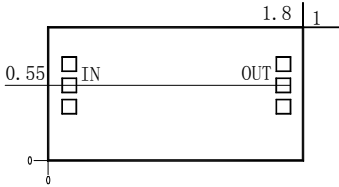
m2
Freq:5.6GHz
dB(S(2,1)) = 20

m3
Freq:6.2GHz
dB(S(2,1)) = 40

回波损耗



外形和端口尺寸（mm）



推荐装配图



绝对额定最大值

最大输入功率	+27dBm
工作温度	-55℃~125℃
存储温度	-65℃~150℃

注意事项

1. 芯片在干燥、氮气环境中存储，在超净环境使用；
2. GaAs 材料较脆，不能触碰芯片表面，使用时必须小心；
3. 芯片用导电胶或合金烧结（合金温度不能超过 300℃，时间不能超过 30 秒），使之充分接地；
4. 芯片微波端口与基片间隙不超过 0.05mm，使用 Φ25μm 双金丝键合，建议金丝长度 250~400μm；
5. 芯片微波端无隔直电容；
6. 芯片对静电敏感，在储存和使用过程中注意防静电。